

e_a и m_a — заряд и масса частицы, W — спектральная плотность энергии электростатич. колебаний, удовлетворяющая квазилинейному ур-нию

$$\frac{\partial W}{\partial t} = 2\gamma W. \quad (3)$$

В ур-нях (1) — (3) частота $\omega = \omega(k, t)$ и инкремент флукутаций поля $\gamma = \gamma(k, t)$ определяются ф-лами, справедливыми и в линейной теории:

$$\epsilon(\omega, k) = 1 + \sum_a \frac{4\pi e_a^2}{k^2} P \int \frac{k (\partial f_a / \partial p)}{\omega - k v_a} d^3 p, \quad (4)$$

$$\gamma = \left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \omega} \right)^{-1} \sum_a \frac{4\pi e_a^2}{k^2} \int k^2 \frac{\partial f_a}{\partial p} \delta(\omega - k v_a) d^3 p. \quad (5)$$

Разница состоит в том, что f_a в линейной теории считается не зависящей от времени, в К. т. п. учитывается влияние развивающихся или развитых колебаний на ф-цию распределения заряж. частиц при условии адиабатич. подстройки колебаний под эти медленно меняющиеся ф-ции. К. т. п. описывает релаксац. процессы, происходящие в плазме, мало отличающейся от равновесной при развитии в ней неустойчивостей, называемых обычно кинетическими (пучковой, ионно-звуковой и т. д.). Критерий применимости ур-ний (1) — (5) есть $k\Delta\nu/\omega \gg \gamma$, где $\Delta\nu$ — характерный разброс частиц по скоростям. Из (1) — (5) следует, что в бесстолкновительной плазме без магн. поля характер релаксации частиц определяется диффузией в пространстве скоростей. Так, напр., в наиб. простом, одномерном случае ленгмюровские колебания, возбуждаемые при развитии пучковой неустойчивости, приводят к диффузии частиц по скоростям, в результате чего в области взаимодействия частиц и волн ф-ции распределение частиц слаживается, на ней образуется плато. Неустойчивость при этом стабилизируется [1] — [2]. В более сложных случаях, напр. для неоднородной плазмы в магн. поле, диффузия возникает не только в пространстве скоростей, но и в обычном пространстве [3]. Общий вид квазилинейного ур-ния для магнитоактивной плазмы приведён в [4].

Ур-ния К. т. п. используются только для слаботурбулентной плазмы, для описания турбулентности плазмы необходимы более общие ур-ния.

Лит.: 1) А р ц и м о в и ч Л. А., С а г д е е в Р. З., Физика плазмы для физиков, М., 1979; 2) В е д е н о в А. А., Р у т о в Д. Д., Квазилинейные эффекты в потоковых неустойчивостях, в кн.: Вопросы теории плазмы, т. 6, М., 1972; 3) Х о р т о н В., Дрейфовая турбулентность и аномальный перенос, пер. с англ., в кн.: Основы физики плазмы, т. 2, М., 1984; 4) Б е л и к о в В. С., Н о л е с и ч и ч е н о Я. И., О р а в с к и й В. Н., Непинейная теория термоядерной альфа-генерации неустойчивости плазмы, «ЖЭТФ», 1974, т. 66, Ю. Л. К л и м о н т о в и ч, В. Н. О р а в с к и й.

КВАЗИНЕЙТРАЛЬНОСТЬ ПЛАЗМЫ — одно из важнейших её свойств, заключающееся в практическом равенстве плотностей входящих в её состав положит. и отрицат. заряж. частиц. В этом случае положит. и отрицат. пространственные заряды ионов и электронов компенсируют друг друга и полное электрич. поле внутри плазмы приблизительно равнонулю. К. п. объясняется тем, что при возникновении даже весьма малой избыточной плотности заряда одного к.-л. знака появляются большие электрич. поля, присущие дальнейшему разделению зарядов.

К. п. может нарушаться на расстояниях порядка *дебавского радиуса экранирования* и на время $\lesssim 1/\omega_{pe}$ (ω_{pe} — плазменная частота). При исследовании низкочастотных процессов в плазме плотности электронов и ионов можно считать приблизительно равными, а вместе с тем электрич. поля — не равными нулю. Истинные значения полей определяются примерным равенством энергии заряда в поле и кинетич. энергии. Следствием К. п. является амбиполярный характер диффузии плазмы (см. Амбиполярная диффузия). См. подробнее в ст. *Плазма* и лит. при ней.

С. С. М о у с е е в.

КВАЗИОДНОМЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — соединения, имеющие цепочечную структуру со слабым перекрытием электронных волновых ф-ций соседних цепочек. Электронный спектр К. с. анизотропен, и зона проводимости вдоль цепочек значительно превосходит ширину зоны в направлении, перпендикулярном цепочкам. В результате электропроводность вдоль цепочек $\sigma_{||}$

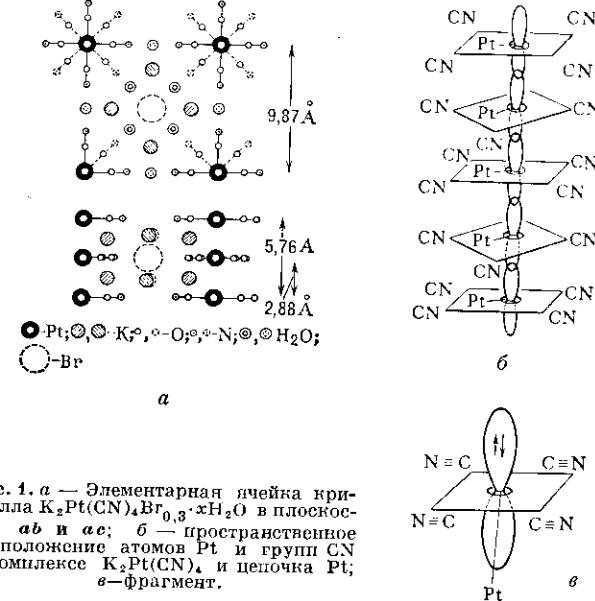


Рис. 1. а — Элементарная ячейка кристалла $K_2Pt(CN)_4Br_{0.3} \cdot xH_2O$ в плоскостях ab и ac ; б — пространственное расположение атомов Pt и групп CN в комплексе $K_2Pt(CN)_4$ и цепочка Pt—CN; в — фрагмент.

значительно превышает электропроводность в перпендикулярных направлениях σ_{\perp} . К. с. относят к неск. классам соединений: 1) плоско-квадратные комплексы типа $K_2Pt(CN)_4Br_{0.3} \cdot xH_2O$ (рис. 1, а), где атомы Pt образуют параллельные цепочки, окружённые группами CN (рис. 1, б, в), и кристаллы из полимеров, напр. полиакетилены ($-\text{CH}=\text{CH}-$)_x и полисульфурни-трида (SN_x). Движение электронов по зоне, образованной атомами Pt (вытянуты вдоль цепочки) в платиновых комплексах и по цепи сопряжения $=\text{C}=\text{C}=$ в полиакетилене, оказывается довольно свободным; перекрестья электропроводности между цепочками сильно затруднены из-за большого межцепочечного расстояния. В результате при $T=300$ К $\sigma_{||}/\sigma_{\perp} \approx 2 \cdot 10^2$. 2) Ион-радикальные соли на основе плоских органич. молекул типа тетрацианхиподимистана (TCNQ), тетратиофульвалена (TTF, рис. 2, а) или тетраметилтетраселенофульвалена (TMTSF). Плоские органич. молекулы в кристаллах этого типа упаковываются в столбики, между которыми помещаются ионы противоположного знака (рис. 2, б, в). Цепь сопряжения внутри молекулы и перекрестье π -электронных волновых ф-ций соседних молекул в колонке позволяют электронам свободно двигаться вдоль столбиков, но перекрестья электропроводности между колонками затруднены из-за их большого удаления друг от друга ($\sigma_{||}/\sigma_{\perp} \sim 10-10^3$). 3) Неорганические соединения, напр. трихалькогениды (TaS_3 , NbSe_3), также могут образовать кристаллы цепочечной структуры с сильной анизотропией электронных свойств квазиодномерного типа (см. также *Органические проводники*).

Мн. К. с. — металлы при $T=300$ К, но переходят в диэлектрич. состояния при понижении T в результате структурного пайерлса перехода, андерсоновской локализации электронов (вследствие беспорядочности структуры) или из-за сильного кулоновского отталкивания электронов (Хаббарда переход, см. *Моттовские диэлектрики*). Пайерлсовский переход